سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
اثر دمای لایه نشانی بر خواص ساختاری و الکتریکی تماس اهمی لایه Au/AuGeNi با n-GaAs

محل انتشار:
سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:
آرش هدایتی - *مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران*

امیر گودرزی - *مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران*

صالح تهمتن - *مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران*

بهرنگ صبرلویی - *مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران*

خلاصه مقاله:
بنابراهمیت تماس اهمی در ادوات نیمه هادی دراین پژوهش اثر دمای زیرلایه n-GaAsبرخواص الکتریکی لایه تماس اهمی Au/AuNi مورد بررسی قرارگرفته است بررسی مشخصه الکتریکی نمونه ها نشان داد که نمونه های لایه نشانی شده در دمای بین 160 درجه تا 200 درجه کمترین مقاومت الکتریکی را دارند دلایل این موضوع از دید ریزساختاری و دیداری توسط انالیزهای SPM,XRD بررسی و مورد تحلیل قرارگرفته است.

کلمات کلیدی:
تماس اهمی ، دمای زیرلایه ، لایه نشانی تبخیری ، Au/AuNiGe/n-GaAs

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/105659